

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 24 年 7 月 5 日 (2012.7.5)

【公開番号】特開 2011-44546 (P2011-44546A)  
 【公開日】平成 23 年 3 月 3 日 (2011.3.3)  
 【年通号数】公開・登録公報 2011-009  
 【出願番号】特願 2009-191093 (P2009-191093)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/02 (2006.01)  
 H 0 1 L 21/3205 (2006.01)  
 H 0 1 L 23/522 (2006.01)  
 H 0 1 L 21/768 (2006.01)  
 H 0 1 L 23/532 (2006.01)  
 H 0 1 L 21/28 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/02 C  
 H 0 1 L 21/88 J  
 H 0 1 L 21/88 R  
 H 0 1 L 21/28 3 0 1 B

【手続補正書】  
 【提出日】平成 24 年 5 月 23 日 (2012.5.23)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】0 0 2 2  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【 0 0 2 2 】

次に、図 6 に示すように、無電解めっきにより、拡散バリア層 1 6 上に N i 合金層（第 2 の金属層）1 8 を形成する。この際、P d 活性化処理を前処理として行なうことにより、置換還元性の拡散バリア層 1 6の無電解めっきを実行できる。また、N i 合金層 1 8 を N i P から構成し、その厚さを 0 . 3  $\mu$  m にする。なお、拡散バリア層 1 6 が P d から構成される場合、前処理の P d 活性化処理を省略できる。